



Toshiba Memory Europe presenta los primeros dispositivos de memoria flash embebida UFS 3.0 primeros de la industria

Permite el rendimiento más rápido necesario para la evolución continua de teléfonos inteligentes, tabletas, realidad aumentada / virtual y más

Düsseldorf, Alemania, 23 de enero de 2019 – Toshiba Memory Europe GmbH (TME) ha comenzado a mandar muestras de la versión de 128GB [1] de almacenamiento flash universal (UFS) Ver.3.0 de la industria de dispositivos de memoria flash embebida. La nueva gama utiliza la memoria flash 3D de última generación BiCS FLASH™ de 96 capas de la empresa y está disponible en tres capacidades: 128GB, 256GB y 512GB [2]. Con un rendimiento de lectura / escritura de alta velocidad y un bajo consumo de energía, los nuevos dispositivos son ideales para aplicaciones como dispositivos móviles, teléfonos inteligentes, tabletas y sistemas de realidad virtual / aumentada.

Los consumidores continúan exigiendo un rendimiento cada vez mayor y una mejor experiencia de usuario desde sus dispositivos, y el estándar UFS se está perfeccionando constantemente para

respaldar esta evolución. Debido a su interfaz en serie, UFS admite la impresión a doble cara, lo que permite la lectura y escritura simultáneas entre el procesador central y el dispositivo UFS. Con la introducción de UFS 3.0, JEDEC, el líder mundial en el desarrollo de estándares para la industria de la microelectrónica, ha mejorado las versiones anteriores del estándar UFS para ayudar a los diseñadores de productos a permitir mejoras significativas en dispositivos móviles y aplicaciones relacionadas.

Los nuevos dispositivos integran una memoria flash 3D BiCS FLASH™ de 96 capas y un controlador en un paquete estándar de JEDEC de 11,5 x 13 mm. El controlador realiza la corrección de errores, la nivelación del desgaste, la traducción de direcciones lógicas a físicas y la gestión de bloques defectuosos para el desarrollo simplificado del sistema.

Los tres dispositivos son compatibles con JEDEC UFS Ver. 3.0, incluido HS-GEAR4, que tiene una velocidad de interfaz teórica de hasta 11,6 Gigabits por segundo por línea (x2 líneas = 23,2Gbps), al mismo tiempo que admite funciones que suprimen los aumentos en el consumo de energía. El rendimiento de lectura y escritura secuencial del dispositivo de 512 GB se ha mejorado en aproximadamente un 70 por ciento y un 80 por ciento, respectivamente, con respecto a los dispositivos Toshiba de 256 GB de la generación anterior.

Toshiba fue la primera compañía en introducir dispositivos UFS y los ha estado lanzando desde 2013. La introducción de estos dispositivos UFS Ver. 3.0 mantienen la posición de liderazgo de Toshiba en almacenamiento para dispositivos móviles de próxima generación que continuarán impulsando nuevos avances.

Las muestras de los nuevos dispositivos se mostrarán en el stand de Toshiba (Hall 3A - 424) en la Exposición y Conferencia Embedded World 2019 (26-28 de febrero, Nuremberg, Alemania).

###

Notas:

[1] Los envíos de muestras del dispositivo de 128 GB comenzarán hoy con el resto de la gama para seguir gradualmente después de marzo. La especificación de las muestras puede diferir de la de los productos comerciales.

[2] La densidad del producto se identifica según la densidad de los chips de memoria dentro del producto, no la cantidad de capacidad de memoria disponible para el almacenamiento de datos por parte del usuario final. La capacidad utilizable por el consumidor será menor debido a las áreas de datos generales, el formato, los bloques defectuosos y otras

restricciones, y también puede variar según el dispositivo host y la aplicación. Para más detalles, consulte las especificaciones de producto aplicables. La definición de 1GB = 230 bytes = 1.073.741.824 bytes.

Sobre Toshiba Memory Europe

Nosotros, Toshiba Memory Europe GmbH, somos la división europea de Toshiba Memory Corporation. Nuestra compañía ofrece una amplia línea de productos de memoria flash de gama alta, que incluyen tarjetas SD, memorias USB y componentes de memoria embebidos, además de unidades de estado sólido (SSD). Nuestra empresa tiene oficinas en Alemania, Francia, España, Suecia y el Reino Unido. El presidente de la compañía es Masaru Takeuchi.

Para obtener más información sobre la gama completa de nuestros productos de memoria y SSD, visite <https://www.toshiba-memory.com/>

Datos de contacto para publicación:

Toshiba Memory Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 (0)211 5296-0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

E-mail: support@toshiba-memory.com

Datos de contacto para peticiones editoriales:

Philipp Schiwiek, Toshiba Memory Europe GmbH

Tel: +49 (0) 211 36877 319

E-mail: pschiwiek@toshiba-tme.eu

Emitido por:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 20 8429 6554

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com

Web: www.publitek.com

Ref. TME017A_SPA